

第53回 真空に関する連合講演会

主催： 日本真空学会

協賛： 映像情報メディア学会，応用物理学会，化学工学会，原子衝突研究協会，触媒学会，低温工学・超電導学会，電気学会，電子情報通信学会，日本化学会，日本加速器学会，日本機械学会，日本金属学会，日本顕微鏡学会，日本原子力学会，日本材料学会，日本質量分析学会，日本真空工業会，日本チタン協会，日本鉄鋼協会，日本半導体製造装置協会，日本表面科学会，日本物理学会，日本分析化学会，日本放射光学会，表面技術協会，腐食防食協会，プラズマ・核融合学会（五十音順）

期日： 平成24年11月14日（水）9:30-18:00

平成24年11月15日（木）9:00-17:45 懇親会 18:00-19:30

平成24年11月16日（金）9:00-15:30

会場： 甲南大学ポートアイランドキャンパス（兵庫県神戸市中央区港島南町7丁目1-20）

アクセスマップウェブページ http://www.konan-first.jp/map_a.html

A会場（口頭発表）7F レクチャーホール

B会場（口頭発表）6F 602 講義室

C会場（ポスターセッション，企業展示）7F レクチャールーム

懇親会場 7F カフェテリア

参加費： 日本真空学会学生会員 2,000円

日本真空学会個人会員及び法人会員に属する個人ならびに協賛学協会の会員 4,000円

非会員 5,000円

予稿集代金 2,500円

懇親会 3,000円

クレジットカードによる事前登録が可能です。連合講演会のウェブページ (<http://www.vacuum-jp.org/CONFV/asvsj2012/index.html>) をご参照ください。

入会のご案内： 日本真空学会学生会員の年会費は4,000円ですが，機関誌の配布を希望しない場合は2,000円になります。学会のウェブページ (<http://www.vacuum-jp.org/>) の入会方法および入会申込書を参考にしてください。

併設展示会および展示企業プレゼンテーション：本年度もポスター発表会場（C会場）において，新製品の紹介と産学の架け橋をすべく，企業展示会（11月14日および11月15日）を開催いたしますので是非お立ち寄り下さい。期間中には展示企業プレゼンテーション（11月14日12:45-13:45，11月15日12:45-13:45予定）をB会場にて、参加者にはランチ提供(数量限定)を行い開催致します。企業詳細は上記学会ウェブページでお知らせします。

企業展示出展： 18社。他にカタログ出展1社。

プロシーディングス: 今回の連合講演会のプロシーディングスは、会誌「Journal of the Vacuum Society of Japan」
として発行する予定です。詳細については、連合講演会のウェブページ上でご案内いたします。
尚、平成 23 年 7 月の投稿規程改訂により、受賞講演、特別講演、シンポジウム講演以外の一般
投稿については投稿料が必要となります。
投稿規程 (<http://www.vacuum-jp.org/EDT/edthome.html>) をご参照ください。

その他: 連合講演会の会期前または会期中に、会場にて下記の行事が開催されます。御興味のおありの方は連合
講演会とあわせてご参加ください。

(1) スクールコース (教育委員会) 11月16日(金) 9:00~12:30 6階D会場

真空下での現象や薄膜作成などにおいて真空装置が必要になりますが、いざ真空装置を自分で設計・製作しよ
うとすると、どこまで圧力を下げれば良いのか、それが容易に達成できるかといった疑問、真空用材料や真空
ポンプの選定などの問題が発生します。本講座では、超高真空装置を試作する場合の諸問題について、その科
学的背景(材料の放出ガス、ポンプや真空計の選択、加熱脱ガスの本質的な役割、等々)を踏まえて講義しま
す。詳細は 17 ページ及び日本真空学会ウェブページ: スクールコースの案内をご覧ください。

(2) 産学連携委員会例会 11月15日(木) 10:00~12:30 6階D会場

プログラム詳細は 16 ページに記載されております。また、日本真空学会のホームページ (HP) にもアップさ
れておりますので、参加ご希望の方は HP よりお申込みください。また、当日申込みも受付ます。多くの皆さ
まのご参加をお待ちしています。

(3) 第 3 回真空・表面若手勉強会 11月12日(月), 13日(火)

“真空”と“表面”をキーワードに若手研究者(助教・大学院生等)を対象とした総合的な勉強会を開催致しま
す。本会では、①様々な物理・化学現象に対する理解の深化、②新たな課題解決方法・研究テーマの創出、③
若手研究者のネットワーク形成を目指します。勉強会としての効果・参加者間の知的交流を深めるために、質
疑応答時間に重きを置いた講師講演&フレンドリーな雰囲気のポスターセッションを企画しております。プロ
グラム等の詳細は、<https://sites.google.com/site/ysurfscisem/home>に掲載しています。若手研究者の皆様、奮
ってご参加下さい！
世話人代表: 杉本敏樹(京都大学)

第53回真空に関する連合講演会 受賞記念講演・シンポジウム・特別講演一覧

発表番号	講演題目	講演者	セッション名	期日	時間	会場
技術賞 受賞記念 講演	環境制御型透過電子顕微鏡の開発とその 応用	矢口紀恵 (日立ハイテクノロ ジーズ)	受賞記念講演	11/14	9:45- 10:05	A
進歩賞 受賞記念 講演	Ag(111)表面上の水素分子のオルソ・パ ラ転換におけるファン・デル・ワールス 力の影響	國貞雄治 (阪大院工)	受賞記念講演	11/14	10:05- 10:25	A
進歩賞 受賞記念 講演	Formation of WO ₃ Reduction Coloring Thin Film Using a Combination Sputter- ing Method Featuring Radio-Frequency Oxygen Plasma Irradiation	野口大輔 (都城高専)	受賞記念講演	11/14	10:25- 10:45	A
会誌賞 受賞記念 講演	物理的蒸着法による薄膜のナノ形態制御	鈴木基史 (京大院工)	受賞記念講演	11/14	10:45- 11:15	A
14Aa-3	医工産学連携プロジェクトによる次世代 型生体適合性血管内治療デバイスの開発	長谷部光泉 (東海大医学部)	表面工学	11/14	12:00- 12:30	A
14Ap-1	高効率電力変換用SiCパワーデバイスの 特徴と進展	木本恒暢 (京大院工)	シンポジウム	11/14	16:05- 16:30	A
14Ap-2	SiCデバイス開発とパワエレ機器への展 開	今泉昌之 (三菱電機)	シンポジウム	11/14	16:30- 16:55	A
14Ap-3	ダイヤモンド半導体のパワーデバイス展 開	小出康夫 (物材機構)	シンポジウム	11/14	17:10- 17:35	A
14Ap-4	GaNパワーデバイス開発の現状と課題	上杉 勉 (豊田中研)	シンポジウム	11/14	17:35- 18:00	A
15Aa-6	MOCVD法によるナノサイズ強誘電体の 作製とその物性	藤沢浩訓 (兵庫県立大工)	ナノ構造	11/15	10:15- 10:45	A
15Aa-11	原子間力顕微鏡による分子スケール固液 界面計測の最近の動向	山田啓文 (京大工)	表面科学 I	11/15	12:00- 12:30	A
15Ba-1	表面科学における真空技術	岡野達雄 (放送大学)	真空科学技術 II	11/15	09:00- 09:30	B
15Ba-7	色弱模擬フィルタ「バリエントール」の 開発	宮澤佳苗 (伊藤光学工業)	薄膜 I	11/15	11:00- 11:30	B
15Ap-1	高輝度・高スピン偏極低エネルギー電子 顕微鏡の開発とスピントロニクス磁性薄 膜への応用	越川孝範 (大阪電通大)	基調講演	11/15	16:00- 16:50	A
15Ap-2	モノづくり企業における環境技術	太田賢司 (シャープ)	基調講演	11/15	16:50- 17:40	A
16Aa-13	放射光を用いた薄膜評価とDLC膜の国際 標準化	神田一浩 (兵庫県立大高度研)	薄膜 III	11/16	12:15- 12:45	A
16Ba-6	放射光STMによるナノスケール元素分 析と制御	齋藤 彰 (阪大院工)	表面科学 II	11/16	10:15- 10:45	B
16Ap-1	電流誘起磁壁移動現象の物理と応用	小野輝男 (京大化研)	応用表面科学	11/16	13:45- 14:15	A
16Bp-6	自動車環境技術でのプラズマ利用研究	田中裕久 (ダイハツ工業)	プラズマ科学技術	11/16	15:00- 15:30	B

第53回真空に関する連合講演会プログラム

—11月14日(水)—

A会場 午前の部

【開会式・表彰式・受賞記念講演】 9:30-11:15

開会の挨拶・表彰式 9:30-9:45

受賞記念講演 9:45-11:15

- 真空技術賞 環境制御型透過電子顕微鏡の開発とその応用…………… (株)日立ハイテクノロジーズ¹・山梨大²)
°矢口紀恵¹・長久保康平¹・松本弘昭¹・柿林博司¹・上野武夫²)
- 真空進歩賞 Ag(111)表面上の水素分子のオルソ・パラ転換におけるファン・デル・ワールス力の影響
…………… (阪大院工)°國貞雄治
- 真空進歩賞 Formation of WO₃ Reduction Coloring Thin Film Using a Combination Sputtering Method Featuring Radio-Frequency Oxygen Plasma Irradiation …………… (都城高専)°野口大輔
- 真空会誌賞 物理的蒸着法による薄膜のナノ形態制御 …………… (京大院工)°鈴木基史

◀休憩▶

A会場 午前の部

口頭発表Ⅰ 【表面工学】 11:30-12:30

- 14Aa-1 静電吸着による表面付着微粒子の除去…………… (大島商船高専)°高橋主人
- 14Aa-2 The tribological properties of Diamond-Like Carbon (DLC) films prepared by a variety of deposition methods
…………… (株)さがみはら産業創造センター¹・神奈川県産業技術センター²・慶大³)
°須藤理枝子¹・金子 智²・堀内 崇²・鈴木哲也³)
- 14Aa-3 医工産学連携プロジェクトによる次世代型生体適合性血管内治療デバイスの開発
…………… (東海大医¹・慶大理工²・東大医³)
°長谷部光泉^{1,2}・吉本幸洋²・堀田 篤²・高橋孝喜³・鈴木哲也²)

B会場 午前の部

口頭発表Ⅱ 【真空科学技術Ⅰ】 11:30-12:30

- 14Ba-1 水晶振動子式水素漏洩検知器における温度の影響とその補正方法
…………… (産総研¹・バキュームプロダクツ²・アイピーアイ³)°鈴木 淳¹・北條久男²・小林太吉³)
- 14Ba-2 スニッフア法用標準リークの校正システムの開発
…………… (産総研計測標準)新井健太・吉田 肇・平田正紘・小島時彦
- 14Ba-3 チタン材料の溶存水素に対する真空アニール効果
…………… (山口大院理工¹・UBE科学分析センター²)°栗巢普揮¹・山本節夫¹・竹田将利²・中川浜三²)
- 14Ba-4 昇温脱離法によるガス放出量の定量測定
…………… (産総研¹・電子科学株式会社²)°吉田 肇¹・新井健太¹・小島時彦¹・浦野真理²・平下紀夫²)

◀休憩▶

B会場 昼の部

企業プレゼンテーションⅠ 12:45-13:45

C会場 昼の部

展示会 11:00-16:00

ポスターセッションⅠ 13:45-15:45 (奇数番コアタイム 13:45-14:45 偶数番コアタイム 14:45-15:45)

- 14P-1 J-PARC 3GeVシンクロトロン用大口径Tiペローズ
…………… (原子力機構¹・(株)サンテック²)萩原徳男¹・神谷潤一郎¹・金正倫計¹・小泉欧児²)
- 14P-2 J-PARC 3GeV シンクロトロンにおけるキッカー電磁石フェライトコアの脱ガス処理
…………… (原子力機構)°萩原徳男・菅沼和明・引地裕輔・西川雅章・柳橋亨・神谷潤一郎・金正倫計
- 14P-3 大強度陽子加速器施設J-PARCのMRにおける真空圧力のビーム依存性
…………… (高エネ研)°魚田雅彦・堀洋一郎・齊藤芳男
- 14P-4 小型エネルギー回収型線形加速器の真空システム設計
…………… (高エネ研)°谷本育律・本田 融・高井良太・帯名 崇・野上隆史・浅岡聖二
- 14P-5 非蒸発ゲッター (NEG)ピルを使ったNEGポンプの製作
…………… (高エネ研)°菊地貴司・間瀬一彦・飯塚敏江
- 14P-6V 極高真空計測の信頼性試験…………… (産総研)°吉田 肇・新井健太・小島時彦

- 14P-7 B-A真空計の感度係数変化に関する数値シミュレーション…………… (産総研) °杉沼茂実・平田正紘・小島時彦
- 14P-8 気体粘性計測用振動子のオゾンガスに対する酸化耐性の向上
…………… (産総研¹)・VP²)・VPI³) °黒河 明¹)・北条久男²)・小林太吉³)
- 14P-9 合成樹脂を用いた材料の気体放出速度測定…………… (高工研) °佐藤吉博
- 14P-10V 低抵抗アルミナセラミックスにおける真空中の沿面耐電圧と帯電分布の関係
…………… (埼大理工¹)・高エネ研²)・京セラ³)
°福田英昭¹)・山納 康¹)・小林信一¹)・道園真一郎²)・齊藤芳男²)・前田岳志³)
- 14P-11 低残留放射能材の真空材料への可能性について…………… (原子力機構) °神谷潤一郎・荻原徳男・金正倫計
- 14P-12 表面析出現象を利用した材料開発…………… (物材研) °土佐正弘・佐々木道子・後藤真宏・笠原 章
- 14P-13V イオンビーム分析用多チャンネルシリコン検出器の開発
…………… (筑波大数理) °千東謙太・関場大一郎・島添健次・高橋浩之
- 14P-14V Activation barrier for oxygen atom migration in alkaline-earth doped monoclinic lanthanum germanate
…………… (阪大院工) TRAN Phan Thuy Linh・Mamoru Sakaue・Hideaki Kasai
- 14P-15V Spin effects in metal surface reaction : O₂ on ferromagnetic Pt/M
…………… (阪大院工) Mary Clare Sison Escaño・Tien Quang Nguyen・Hiroshi Nakanishi・Hideaki Kasai
- 14P-16V Theoretical study of the structure and stability of borohydride on gold alloys
…………… (阪大院工) Ryan Lacdao Arevalo・Mary Clare Sison Escano・Hideaki Kasai
- 14P-17V DFT+U investigation on the adsorption and dissociation of oxygen on Pt-coated Ceria
…………… (阪大院工) Tien Quang Nguyen・Hideaki Kasai
- 14P-18 A Density Functional Theory Study on the Oxygen Reduction Reaction on Co-(6)Ppy Cluster
…………… (阪大院工) Adhitya G. Saputro and Hideaki Kasai
- 14P-19V A First Principles Study on the Structural Stability and Electronic Structure of the Montmorillonite - Based Organoclay
…………… (阪大院工) Triati Dewi Kencana Wungu・Hideaki Kasai
- 14P-20V A theoretical study on ZnP interaction with O₂ via ZnP-O₂ complexes using density functional theory
…………… (阪大院工) Febdian Rusydi・Hideaki Kasai
- 14P-21 準安定原子誘起電子分光法によるSi/6H-SiC(0001)表面の電子状態抽出
…………… (宇部高専¹)・九工大工²) °森岡明大¹)・村岡幸輔¹)・内藤正路²)・碓 智徳¹)
- 14P-22V N₂並進運動エネルギー誘起Al(111)窒化膜の成膜温度による膜質の変化と773K以下における熱変性
…………… (原子力機構¹)・兵庫県立大院物質理学²)・東北大多元研³)・筑波大院⁴)
°神農宗徹^{1,2})・寺岡有殿^{1,2})・高岡 毅³)・岡田隆太^{1,4})・
岩井優太郎^{1,2})・吉越章隆¹)・米田忠弘³)
- 14P-23 STMにより観察されるSi(113)面のK吸着構造…………… (横国大院工) °成重卓真・大野真也・田中正俊
- 14P-24V 高感度電子-電子-イオンコインシデンス分光装置の性能評価とSi-LVVオージェ電子-Si 2s光電子コインシデ
ンス分光測定…………… (横国大院工¹)・群馬大教育²)・千葉大院融合科学³)・愛媛大院理工⁴)・KEK物構研⁵)
°平賀健太¹)・新江定憲¹)・兼村瑠威¹)・小柏洋輔²)・梁瀬虹太郎²)・金山典嗣³)・
大野真也¹)・垣内拓大⁴)・間瀬一彦⁵)・奥平幸司³)・奥沢 誠²)・田中正俊¹)
- 14P-25 低速原子散乱分光によるMgO表面原子構造解析…………… (阪府大(総)) °梅澤憲司
- 14P-26V 電子線を照射したKBr表面で散乱した高速陽子の強度分布初期振動のシミュレーション……………
…………… (大阪教育大理科教育講座) °深澤優子・木原一道・岩本恒平・鈴木康文
- 14P-27V NaCl蒸着膜表面における環状水ヘキサマー生成と加熱による構造変化
…………… (学習院大理¹)・東大生研²) °山川紘一郎¹)・福谷克之²)
- 14P-28 低温低圧柱状プラズマを用いた球状炭素粒子の形成と構造解析
…………… (九工大工¹)・宇部高専²)・九州共立大³)
中山泰輔¹)・大久保雄平¹)・飯倉泰成¹)・碓 智徳²)・内藤正路¹)・生地文也³)・長井達三³)
- 14P-29 イオン液体混合物の表面組成分析…………… (京大工) °宮下基希・中嶋 薫・鈴木基史・木村健二
- 14P-30 シャープペンシル芯断面からの電界電子放出
…………… (筑波大数物) °遠藤俊宏・堀江翔太・山田洋一・佐々木正洋
- 14P-31 W<111>エミッターの熱電界処理によるNanotipの作製
…………… (名城大理工¹)・島津製作所²) °池谷康生¹)・徳竹謙介¹)・藤田 真^{1,2})・大江俊美¹)
- 14P-32 SiC微粒子からの電界放射電流の時間変化…………… (東洋大理工¹)・三重大工²) 吉本智巳¹)・岩田達夫²)
- 14P-33 FIB TOF-SIMSによるコバルト酸リチウムと酸化コバルトのスペクトル比較……………
…………… (工学院大¹)・三井化学²) °大西美和¹)・松岡 修²)・野木栄信²)・坂本哲夫¹)

- 14P-34 バンドダイアグラム測定装置の開発…………… (物材機構) °柳生進二郎・吉武道子・後藤真宏・知京豊裕
 14P-35 二酸化シリコンへのゲルマニウム負イオン注入と発光特性
 …………… (京大院工¹・シャープ基盤技研²)。辻 博司¹・宮川 豪¹・洗 暢俊²・後藤康人¹
 14P-36 低エネルギーイオンビーム照射によるPMMAエッチングイールドへの紫外線照射および水素プラズマ暴露の
 影響 …………… (阪大工¹・産総研²)。幾世和将¹・吉村 智¹・杉本敏司¹・木内正人^{1,2}・浜口智志¹
 14P-37V Mg₂FeH₆の電子状態における水素の量子性の影響
 …………… (筑波大数理¹・東大物性研²・東大院工³・NIMS⁴・東北大金研⁵)
 °栗田圭輔¹・千東謙太¹・関場大一郎¹・原田慈久²・木内久雄³・酒井智香子³・
 尾嶋正治³・袖山慶太郎⁴・館山佳尚⁴・佐藤龍太郎⁵・松尾元彰⁵・折茂慎一⁵
 14P-38 窒化炭素の酸素還元能…………… (岡山理大基礎¹・岡山理大応化²)。財部健一¹・安井 望¹・竹崎 誠²
 14P-39 金ガリウム合金液体金属イオン源におけるガリウムイオン生成機構に関する一考察
 …………… (京大院工) °後藤康仁・辻 博司
 14P-40 Individual Analysis of Diesel Nano-Particles by High Resolution TOF-SIMS
 …………… (工学院大工¹・東工大資源研²・国環研³) °坂本哲夫¹・三澤健太郎²・藤谷雄二³
 14P-41 PCR用可搬型サーマルサイクラーの放熱と熱応答…………… (神奈川大工¹・神奈川大総理研²・神奈川大理³)
 °奥脇容子¹・山口栄雄¹・鈴木 温²・井上和仁³・安積良隆³
 14P-42 微小材料機械強度測定装置の開発…………… (物材機構) °笠原 章・鈴木 裕・佐々木道子・後藤真弘・土佐正弘
 14P-43 レーザー昇温熱脱離におけるクヌーセン層形成
 …………… (東大生研) °池田暁彦・松本益明・小倉正平・岡野達雄・福谷克之

◀休憩▶

A会場 午後の部

シンポジウム「省エネルギー社会の実現に貢献する半導体パワーデバイス」15:55-18:00

- 14Ap-1 高効率電力変換用SiCパワーデバイスの特徴と進展 …………… (京大工) 木本恒暢
 14Ap-2 SiCデバイス開発とパワーエレ機器への展開 …………… (三菱電機) °今泉昌之
 14Ap-3 ダイヤモンド半導体のパワーデバイス展開…………… (物材機構) 小出康夫
 14Ap-4 GaNパワーデバイス開発の現状と課題…………… (豊田中研) °上杉 勉・加地 徹

—11月15日(木)—

A会場 午前の部

口頭発表Ⅲ 【ナノ構造】 9:00-10:45

- 15Aa-1 平面型カーボンナノチューブフィールドエミッタの電界放出特性における陰極表面モルフォロジの影響
 …………… (三重大院工¹・名大院工²)。嶋中康太¹・大原一馬¹・佐藤英樹¹・齊藤弥八²
 15Aa-2 走査電子顕微鏡観察下マニピュレーションによるMoS₂チャネル3端子デバイスの作製とその電気特性評価
 …………… (産総研¹・千葉工大²)。安藤 淳¹・清水哲夫¹・菅 洋志²・森田行則¹
 15Aa-3 Si(111)上GaGdN/AlN/GaGdNナノロッドの形成とその評価 …………… (阪大産研) °木村真理子・長谷川繁彦
 15Aa-4 GaAs系半導体の誘電体ロッド型フォトニック結晶構造作製技術の検討
 …………… (阪大院工) °後藤洋昭・森藤正人・石川史太郎
 15Aa-5 ナノチャネルを有する強誘電体ゲート薄膜トランジスタの作製とその電気特性評価
 …………… (阪府大院工) °野村侑平・吉村 武・藤村紀文
 15Aa-6 MOCVD法によるナノサイズ強誘電体の作製とその物性…………… (兵庫県大) °藤沢浩訓・中嶋誠二・清水 勝

◀休憩▶

口頭発表Ⅳ 【表面科学Ⅰ】 11:00-12:30

- 15Aa-7 Ni(111)表面のO₂分子による室温における酸化反応ダイナミクス …………… (原子力機構¹・兵庫県大²・筑波大³)
 °寺岡有殿^{1,2}・井上敬介^{1,2}・神農宗徹^{1,2}・吉越章隆¹・岡田隆太^{1,3}
 15Aa-8 超音速O₂分子線とバックフィリングによるGe(100)-2×1上の室温飽和酸化膜の違い
 …………… (原子力機構¹・筑波大院数物²・兵衛大院物質学³)
 °吉越章隆^{1,2}・岡田隆太^{1,2}・寺岡有殿^{1,3}・神農宗徹^{1,3}・山田洋一²・佐々木正洋²
 15Aa-9 Si高指数面熱酸化過程におけるSiO₂/Si界面構造と電子状態…………… (横国大工¹・原子力機構²・産総研³)
 °安部壮祐¹・大野真也¹・兼村瑠威¹・吉越章隆²・寺岡有殿²・尾形祥一¹・安田哲二³・田中正俊¹
 15Aa-10 Ne表面上に吸着した水クラスターの赤外分光研究
 …………… (学習院大理) °武隈真一・小澤 望・山川紘一郎・荒川一郎

15Aa-11 原子間力顕微鏡による分子スケール固液界面計測の最近の動向…………… (京大工) °山田啓文

B会場 午前の部

口頭発表V 【真空科学技術II】 9:00-10:45

- 15Ba-1 表面科学における真空技術…………… (放送大学)岡野達雄
15Ba-2 低温銅表面に物理吸着した水素の吸着等温線… (学習院大理) °清水英行・加藤 渉・山川紘一郎・荒川一郎
15Ba-3 高感度ガス分析装置によるEIマススペクトルの同定解析
…………… (原子力機構¹・東京ビジネスワーク²)秦野歳久¹・平塚 一¹・藤田恵一²・阿部哲也¹
15Ba-4 J-PARCリニアックACS加速空洞の圧力分布解析
…………… (東工大原子炉研¹・高エネ研²・原子力機構³)・林崎規託¹・齊藤芳男²・青 寛幸³
15Ba-5 圧力-吸着状態密度変換式による実排気曲線の解析
…………… (東大生研¹・京大理²) °武安光太郎¹・杉本敏樹²・福谷克之¹
15Ba-6 δ関数型の吸着状態密度を持つ真空容器内のガスの挙動
…………… (京大院理¹・東大生研²) °杉本敏樹¹・武安光太郎²・福谷克之²

◀休憩▶

口頭発表VI 【薄膜I】 11:00-12:30

- 15Ba-7 色弱模擬フィルタ「バリエントール」の開発
…………… (伊藤光学工業¹・豊橋技科大²) °宮澤佳苗^{1,2}・小田博文¹
15Ba-8 高周波支援パルススパッタリング法によるTiO₂薄膜堆積における高周波支援電力および放電圧力の薄膜構造
および物性への影響 …………… (金沢工大高度材料センター¹・東洋紡²)
°田村洋一¹・坂本宗明¹・三好佳太¹・山下正光¹・草野英二¹・大谷寿幸²
15Ba-9 TSVへのCuシード膜の成膜とその評価 …………… (新明和工業¹・阪府大院工²)
°土屋貴之¹・丸中正雄¹・林 太郎²・岡本尚樹²・齊藤丈靖²・横井昌幸²・近藤和夫²
15Ba-10 酸化亜鉛薄膜の真空摩擦特性…………… (物材機構MANA¹・物材機構先高材ユニット²)
°後藤真宏¹・佐々木道子²・笠原 章²・土佐正弘²
15Ba-11 コンピナトリアルスパッタ法で作製したホウ素添加ZnO薄膜の摩擦特性評価
…………… (物材機構) °佐々木道子・後藤真宏・笠原 章・土佐正弘

◀休憩▶

B会場 昼の部

企業プレゼンテーション2 12:45-13:45

C会場 昼の部

展示会 9:00-15:45 (16:00)

ポスターセッション2 13:45-15:45 (奇数番コアタイム 13:45-14:45 偶数番コアタイム 14:45-15:45)

- 15P-1V 反応性スパッタリング法によるPdO_x薄膜の光触媒特性
…………… (明大物性研) °遠藤勇氣・勝又俊覚・平沢一樹・安西道彦・三浦 登・松本皓永
15P-2V 銅添加酸化タンゲステン薄膜のエレクトロクロミズム特性
…………… (明大物性研) °勝又俊覚・遠藤勇氣・松島 涼・金田 諭 ・三浦 登・松本皓永
15P-3V RAS (Radical Assisted Sputtering) 法により作製したTa₂O₅固体電解質薄膜の特性改善に関する研究
…………… (都城高専¹・(株)ホンダロック²・(株)シンクロン³)
°西田悠光¹・野口大輔¹・清 文博²・河野慶彦²・福留政治²・佐井旭陽³
15P-4 酸化クロム薄膜ひずみゲージを用いた触覚センサシステムの開発
…………… (大阪府産技研) °松永 崇・金岡祐介・日下忠興
15P-5 軟X線吸収分光法と光電子分光法による酸化マグネシウム薄膜表面の研究
…………… (九州シンクロトロン光研究センター) °小林英一・岡島敏浩
15P-6 高周波スパッタMgO薄膜の二次電子放出および絶縁破壊特性の製膜時ガス環境依存性
…………… (成蹊大理薄膜研) °小曾根良介
15P-7 紫外線遮蔽CeO₂コーティングにおける応力低減と紫外線遮蔽能の最適化
…………… (金工大高度材料センター¹・宇宙航空研究開発機構²)
°高橋知大¹・坂本宗明¹・ト部 暁¹・平田直希¹・草野英二¹・宮崎英治²・木本雄吾²・森 一之²
15P-8V SiO₂をドーパしたZnO系薄膜へのレーザーアニール(II)…………… (大産大)伊島匡亮・°青木孝憲・鈴木晶雄
15P-9V PLD法で作製したZrO/ZnO系透明導電膜の耐熱特性…………… (大産大)馬 中岳・°青木孝憲・鈴木晶雄
15P-10V パルスレーザー堆積法による酸化亜鉛透明フレキシブルデバイスの開発
…………… (大工大) °木村祐太・孫 屹・前元利彦・佐々誠彦・井上正崇

- 15P-11V ワイドスペクトル太陽電池用の酸化亜鉛系透明導電膜…………… (大産大) 深瀬智也・青木孝憲・鈴木晶雄
- 15P-12V タッチパネル用TZO透明導電膜の超薄膜領域の特性改善…………… (大産大) 豊川慶晋・青木孝憲・鈴木晶雄
- 15P-13 積層型TiO₂/TiN/Cu₂O薄膜の光機能特性…………… (工学院大) °中嶋拓未・鷹野一朗
- 15P-14V ハイブリッド対向スパッタによるITO 薄膜作製
…………… (山口大工) °諸橋信一・碓井圭太・高木史博・岡田智之・村田卓也・原田直幸
- 15P-15 反応性スパッタリング法を用いたTiO₂-Ni多層薄膜の光機能特性…………… (工学院大工) °豊田重貴子・鷹野一朗
- 15P-16 反応性スパッタ法によるマグネリ相酸化バナジウム薄膜の堆積と相転移特性
…………… (東海大院工) °鈴木康史・沖村邦雄
- 15P-17 反応性スパッタリング法により作製したCu₂O/TiO₂薄膜太陽電池…………… (工学院大) °鈴木優規・鷹野一朗
- 15P-18V ホットウォール高周波スパッタリング法によるCu₂ZnSnS₄薄膜堆積におけるホットウォール温度および放電圧
力の薄膜組成、構造および物性への影響
…………… (金工大高度材料センター) °坂上拓哉・坂本宗明・中村一貴・稲葉駿介・草野英二
- 15P-19 InSbTe薄膜の作製と評価…………… (神奈川大工) °石井孝幸・山口栄雄
- 15P-20 AlN/Ag/AlNナノ積層化による低抵抗透明導電膜の作製
…………… (株清水製作所¹・小川創造技術研究所²) 清水正美¹・安田政智¹・小川倉一²・近藤匡俊²
- 15P-21 CVDを用いたa-C:H薄膜作製における水素取り込み過程の研究…………… (筑波大数理¹・UTTAC²・茨城大工³)
°竹本直嗣¹・藤寄裕之³・石井 聡²・尾関和秀³・関場大一郎^{1,2}
- 15P-22 微斜面(001)CVDダイヤモンド薄膜における表面修飾状態の評価とその大気中安定性
…………… (阪大院工) °内田直樹・毎田 修・伊藤利道
- 15P-23V 低エネルギーイオンビームアシスト法により作製されたDLC薄膜の機械的特性
…………… (工学院大工) °西 勇人・鷹野一朗
- 15P-24 イオンビームアシスト法によりジュラルミン基板上に製膜したDLC薄膜の特性
…………… (工学院大) °高村祐哉・鷹野一朗
- 15P-25 反応性スパッタ法によるNi-N薄膜の作製…………… (岡野製作所¹・小川創造技術研究所²・大阪市大³)
°大西孝則¹・田尻修一¹・岡野夕紀子¹・青園隆司¹・小川倉一²・美馬宏司³
- 15P-26 Co(002)バリア層付き40nmトレンチへの高真空スパッタ法によるCu埋め込み
…………… (東理大工) °飯田浩幸・伊藤勝利・上村貴寛・高橋辰男・中條公太郎・斉藤 茂
- 15P-27V プラズマ電位制御用電極を追加した三極スパッタによる銅薄膜構造の変化
…………… (成蹊大理工) °馬橋琢哉・中野武雄・馬場 茂
- 15P-28V スパッタリングによりポリイミドフィルム上に形成した有機薄膜の摩擦・摩耗特性
…………… (東海大院工¹・東海大工²)
°清野 将¹・森本晋司²・佐々木俊亮²・荒井一樹²・佐藤裕翔²・細矢将司²・岩森 暁²
- 15P-29V ポリテトラフルオロエチレンをターゲットとして高周波スパッタリングにより成膜したフッ化炭素薄膜の揮
発性有機化合物の吸着感度
(東海大院工¹・東海大工²・産総研³) °大西康貴¹・池田佑旭¹・郭 捷²・岩森 暁²・野田和俊³
- 15P-30V ポリテトラフルオロエチレンをターゲットに用いて高周波スパッタリングにより成膜したフッ化炭素薄膜の
熱分解挙動…………… (東海大院¹・東海大²・岩崎電気³・ダイプラ・ウィンテス⁴・有)マイクロアナリスラボ⁵)
池田佑旭¹・岩森 暁²・松本裕之³・西山逸雄⁴・嘉本 律⁵
- 15P-31V 水素雰囲気中EXAFSによるMg₂NiH₄薄膜の構造解析
…………… (筑波大数理¹・KEK-PF²) °綿引悠美¹・仁谷浩明²・関場大一郎¹
- 15P-32V ガスクラスター SIMSによる極浅表面分析…………… (兵庫県大工) °盛谷浩右・乾 徳夫・持地広造
- 15P-33 マイクロハクマク圧力センサによる真空加工装置内の圧力分布計測(2)
…………… (岡野製作所¹・小川創造技術研究所²・大阪市大³)
°田尻修一¹・大西孝則¹・岡田俊一¹・岡野夕紀子¹・青園隆司¹・小川倉一²・美馬宏司³
- 15P-34 ナノ微細構造物の形状並びに結晶配向分布…………… (秋田産技センター) °有明 順・近藤祐治
- 15P-35 GaAs/窒素デルタドープを用いた超格子構造の成長と評価
…………… (阪大院工¹・超高圧電子顕微鏡センター²) °角谷健吾¹・森藤正人¹・大島義文²・石川史太郎¹
- 15P-36V 高温斜め蒸着法によるGa₂O₃ナノワイヤの成長…………… (京大院工¹・国立清華大学²)
°南竹春彦¹・鈴木基史¹・原 英貴¹・中嶋 薫¹・木村健二¹・Chia-Wei Hsu²・Li-Jen Chou²

- 15P-37 Analysis of structural and electronic properties of Pr₂NiO₄ oxide through first principles calculations
 … (Dept. of Applied Physics, Osaka Univ.¹) · Device & System Technology R&D Laboratories, Konica
 Minolta Technology Center²) · Dept. of Applied Chemistry, Kyushu Univ.³)
 Susan Menez Aspera¹) · Mamuro Sakaue¹) · Triati Dewi Kencana Wungu¹) · Musa Alaydrus¹) ·
 Tran Phan Thuy Linh¹) · Hideaki Kasai¹) · Motohiro Nakanishi²) · Tatsumi Ishihara³)
- 15P-38V パルスレーザーを用いた機能性高分子ナノワイヤーの創製
 …………… (物材機構) °佐々木道子 · 後藤真宏 · 笠原 章 · 知京豊裕 · 土佐正弘
- 15P-39V 電子照射によるグラフェンの構造変化の分子動力学解析
 …………… (阪府大院工) °朝山良樹 · 安田雅昭 · 川田博昭 · 平井義彦
- 15P-40 カーボンナノチューブ平面型陰極表面の電子放出サイト面内分布の評価と改善
 …………… (三重大院工¹) · 名大院工²) °佐藤英樹¹) · 大原一馬¹) · 嶋中康太¹) · 齋藤弥八²)
- 15P-41 微細柱状構造高品質CVDダイヤモンドの作製プロセスの適正化とデバイス応用
 …………… (阪大院工) °橋本竜一 · 毎田 修 · 伊藤利道
- 15P-42 CVDダイヤモンドを用いたp-i-p型パワーデバイスの素子構造及び作製プロセスの検討
 …………… (阪大院工) °早川 光 · 毎田 修 · 伊藤利道
- 15P-43 高配向多結晶CVDダイヤモンドにおける高濃度ホウ素ドーブ層の高品質化
 …………… (阪大院工)伊藤利道 · 毎田 修 · °溝端勇介
- 15P-44V 電子線リソグラフィにおけるパターン形成の分子シミュレーション
 …………… (阪府大院) °高井里奈 · 酒井裕史 · 安田雅昭 · 川田博昭 · 平井義彦
- 15P-45 Si(111)基板上GaAsナノワイヤの分子線エピタキシー成長時窒素プラズマ照射効果
 …………… (阪大院工) °荒木義朗 · 石川史太郎

◀休憩▶

A会場 午後の部

基調講演 16:00-17:40

- 15Ap-1 高輝度・高スピン偏極低エネルギー電子顕微鏡の開発とスピントロニクス磁性薄膜への応用
 …………… (大阪電通大¹) · Arizona State Univ.²) · 名大理³) · 名大工⁴) ·
 科学技術振興財団シンクロトロン光センター⁵)
 越川孝範¹) · 鈴木雅彦¹) · 安江常夫¹) · E. Bauer²) · 中西 彊³) · 金 秀光⁴) · 竹田美和⁵)
- 15Ap-2 モノづくり企業における環境技術…………… (シャープ(株)太田賢司

—11月16日(金)—

A会場 午前の部

口頭発表Ⅶ【薄膜Ⅱ】9:00-10:45

- 16Aa-1 コンビナトリアル成膜法によるBZT-BCT非鉛圧電薄膜の作製と圧電特性評価
 …………… (神戸大工) °森 亮 · 神野伊策
- 16Aa-2 シリコン基板上に作製したPZT薄膜積層アクチュエータ…………… (神戸大工) °岸本真哉 · 神野伊策
- 16Aa-3 SrTa酸窒化物の重イオンERDA測定及びそれに用いる電離箱の開発 …………… (筑波大数理¹) · 東大院理²)
 長嶋和毅¹) · °原山 勲¹) · 関場大一郎¹) · 鈴木 温²) · 岡大 地²) · 廣瀬 靖²) · 長谷川哲也²)
- 16Aa-4 有機強誘電体/極性半導体ヘテロ接合電界効果トランジスタにおける分極界面の電気的特性評価
 …………… (阪府大院工) °山田裕明 · 吉村 武 · 藤村紀文
- 16Aa-5 有機強誘電体を用いた磁性半導体Si:Ce薄膜の電界効果
 …………… (阪府大)宮田祐輔 · 高田浩志 · 奥山祥孝 · 吉村 武 · 芦田 淳 · 藤村紀文
- 16Aa-6 微細キャパシタ構造におけるReRAMフィラメントのメモリ特性
 …………… (鳥大工¹) · TEDREC²) °高 相圭¹) · 木下健太郎^{1,2}) · 福原貴博¹) · 岸田 悟^{1,2})
- 16Aa-7 AFM電界酸化を用いた超微細抵抗変化型メモリの作製
 …………… (鳥大工¹) · TEDREC²) °福原貴博¹) · 木下健太郎^{1,2}) · 高 相圭¹) · 澤居優圭¹) · 岸田 悟^{1,2})

◀休憩▶

口頭発表Ⅷ【薄膜Ⅲ】11:00-12:45

- 16Aa-8 斜めスパッタ法により堆積された抵抗変化メモリ(ReRAM)の動作特性
 …………… (鳥大工¹) · TEDREC²) °澤居優圭¹) · 木下健太郎^{1,2}) · 福原貴博¹) · 岸田 悟^{1,2})
- 16Aa-9 遷移金属酸化物抵抗変化メモリにおけるスイッチング特性の材料依存性
 …………… (鳥大工¹) · TEDREC²) °小石遼介¹) · 木下健太郎^{1,2}) · 森山拓洋¹) · 岸田 悟^{1,2})

- 16Aa-10 c-BN膜の耐熱特性 ……………(神港精機¹・兵庫県工業技術センター²・滋賀県東北部工業技術センター³・
株MORESCO⁴・若狭湾エネルギー研究センター⁵)
°野間正男¹・山下 満²・所 敏夫³・島 秀貴⁴・笹瀬雅人⁵)
- 16Aa-11 炭化薄膜の二次電子放出係数……………(東京電機大工)°松田七美男・渡辺直人
- 16Aa-12 ダイヤモンド表面での光電子制御プラズマの放電特性測定……………(東北大多元研¹・国際基督教大²)
川田麻由梨¹・尾白佳大¹・小川修一¹・増澤智昭²・岡野 健²・高桑雄二¹)
- 16Aa-13 放射光を用いた薄膜評価とDLC膜の国際標準化……………(兵庫県立大高度研)°神田一浩

B会場 午前の部

口頭発表IX 【表面科学Ⅱ】 9:00-10:45

- 16Ba-1 ステンレス表面上の透過水素分布の観察
……………(東邦大理¹・物材機構²)°鈴木真司¹・高木祥示¹・後藤哲二¹・村瀬義治²・土佐正弘²・板倉明子²)
- 16Ba-2 Theoretical investigation on adsorption and reaction of hydrazine on metal surfaces.
……………(阪大院工) Mohammad Kemal Agusta・Hideaki Kasai
- 16Ba-3 Density functional theory investigation on the behavior of H atoms on Pd (110) surface
……………(Dept. of Applied Physics, Osaka Univ.¹・Dept. of Chemical Eng., Institut Teknologi Bandung²・
Physics Dept., De La Salle Univ.³) Allan Abraham B. Padama¹・Hideaki Kasai¹・
Yogi Wibisono Bushi²・Nelson B. Arboleda Jr.³)
- 16Ba-4 Si(111)表面酸化状態のO₂圧力依存 ……………(東北大多元研¹・原子力機構²・長岡科技大³)
°唐 佳芸¹・西本 究¹・小川修一¹・吉越章隆²・石塚眞治³・渡辺大輝¹・寺岡有殿²・高桑雄二¹)
- 16Ba-5 Ge(111)-c(2×8)室温酸化において酸素分子の並進運動エネルギーで誘起される酸化状態の分析
……………(原子力機構¹・筑波大院数物²・兵衛大院物質学³)
°岡田隆太^{1,2}・吉越章隆¹・寺岡有殿^{1,3}・神農宗徹^{1,3}・山田洋一²・佐々木正洋²)
- 16Ba-6 放射光STMによるナノスケール元素分析と制御 ……………(阪大院工¹・理研/SPRING-8²・分子研³・物材機構⁴)
°齋藤 彰^{1,2}・田中義人²・香村芳樹²・高木康多³・赤井 恵¹・石川哲也²・桑原裕司^{1,2}・青野正和⁴)

《休憩》

口頭発表X 【表面科学Ⅲ】 11:00-12:45

- 16Ba-7 超音速希ガス原子線散乱による有機単分子層の計測
……………(筑波大数物)°七辺寛幸・渡邊研人・山田洋一・佐々木正洋
- 16Ba-8 表面プラズモンに誘起される分子振動励起……………(阪大院工)°三輪邦之・坂上 護・笠井秀明
- 16Ba-9 coronene単分子層へのアルカリ吸着
……………(筑波大数物)°矢野雅大・岡田遼介・遠藤めぐみ・山田洋一・佐々木正洋
- 16Ba-10 ペロブスカイト型酸化物の薄膜化と強誘電性に関する研究……………(阪大院工)°岡 耕平・中西 寛・笠井秀明
- 16Ba-11 シリコン酸化状態へのチタン吸着効果の解析……………(横国大院工¹・佐賀大シンクロトロン²)
°大野真也¹・安部壮祐¹・高橋和敏²・鎌田雅夫²・田中正俊¹)
- 16Ba-12 W(110)上のCo/Ni多重層における磁気異方性の理論的研究
……………(阪大工¹・大阪電通大²・お茶大理³・アリゾナ州大⁴)°小島一希¹・Wilson Agerico Diño¹・
鈴木雅彦²・安江常夫²・工藤和恵³・阿久津典子²・Ernst Bauer⁴・越川孝範²・笠井秀明¹)
- 16Ba-13 銀表面上0.5ML酸素原子超格子に発現する強磁性状態とその安定性
……………(阪大院工)°國貞雄治・中西 寛・Wilson Agerico Diño・笠井秀明

《休憩》

A会場 午後の部

口頭発表XI 【応用表面科学】 13:45-15:30

- 16Ap-1 電流誘起磁壁移動現象の物理と応用……………(京大化研)°小野輝男
- 16Ap-2 紫外線励起酸素を用いた滅菌システムにおけるチャンバー内の減圧レベルとワークに対する殺菌効果
……………(岩崎電気¹・産総研²・東海大³)°吉野 潔¹・松本裕之¹・岩崎達行¹・木下 忍¹・
野田和俊²・岩森 暁³)
- 16Ap-3 Liイオン電池の充放電特性に与える負極被膜の影響
……………(北大工学院¹・北大工学研究科²)°高丸翔太¹・日野友明²・山内有二²・信太祐二²)
- 16Ap-4 摩擦静電気が引き起こすカソード・ルミネセンス
……………(安衛研¹・学習院大物²)三浦 崇¹・今井悦子²・荒川一郎²)
- 16Ap-5 酸素雰囲気下における下地層の表面偏析予測シミュレーション……………(物材機構)吉武道子
- 16Ap-6 走査型ヘリウムイオン顕微鏡による微細構造解析……………(物材機構)°大西桂子・Hongxuan GUO・藤田大介

B会場 午後の部

口頭発表Ⅻ 【プラズマ科学技術】 13:45-15:30

- 16Bp-1 プラズマプロセスにおけるパラメータゆらぎがSi表面ダメージ層形成に及ぼす影響
..... (京大工) °江利口浩二・松田朝彦・鷹尾祥典・斧 高一
- 16Bp-2 半導体デバイス解析用局所プラズマ加工装置の開発(5)出現質量分析法による吸引ガスの分析
..... (産総研¹)・(株)三友製作所²) °清水哲夫¹・堀江智之¹・内藤泰久¹・岩瀬千克²・林 明宏²・
檜村健太²・白山裕也²・横須賀俊太郎²・新堀俊一郎²・高橋 賢²・徳本洋志²
- 16Bp-3 プローブ法による光電子制御プラズマの空間電位解析
..... (東北大学多元研) °阿加賽見・大友悠大・小川修一・高桑雄二
- 16Bp-4 Arガスを用いた容量結合型RFプラズマ中における金属の電流電圧特性Ⅷ (広大院大工) °久保 隆
- 16Bp-5 クラスタープラズマによる金型用コーティング膜の除去技術..... (福岡工技センター) °池田健一
- 16Bp-6 自動車環境技術でのプラズマ利用研究..... (ダイハツ工業(株)) °田中裕久・内藤一哉・谷口昌司・上西真里

A会場

【閉会式】 15:30-

講演番号の末尾にVが表示されている発表は、優秀ポスター発表の審査対象ポスターです。

発表者へのご案内

1. 口頭発表

講演時間は15分（討論時間5分を含む）です。講演時に使用可能な機材は液晶プロジェクタ（接続コネクタ：mini D-Sub15pin）のみです（ノートパソコンは持参ください）。休憩時間やセッション開始前にファイルの動作確認をお願いいたします。PC不調等の対応については、各自の責任にてお願い致します。コンピュータ持参不可の場合や、機器故障、不調の場合を考慮して、各会場に発表用のパソコンを用意いたします。会場のパソコンを使用する場合は必ずPDF形式のファイルをご準備ください。USBメモリーでのデータ持参をお願いいたします。休憩時間やセッション開始前にファイルの動作確認をお願いいたします。

2. ポスター発表

ポスター掲示時間は下表の通りです。コアタイムではポスターの前で説明をお願いいたします。パネルの大きさは下図のように縦210cm×横90cmです。パネル左上に縦10cm×横20cmの余白をとってください。余白に事務局で講演番号を貼ります。ポスター貼り付けには押しピンのみ使用可能です。押しピンは会場にて用意いたします。

	11月14日（水）	11月15日（木）
掲示開始可能	9:00	9:00
掲示完了	13:00	13:00
コアタイム（奇数）	13:45-14:45	13:45-14:45
コアタイム（偶数）	14:45-15:45	14:45-15:45
撤収開始	15:45	15:45
撤収終了	17:00	17:00

●ポスターボード概略図●

単位：mm

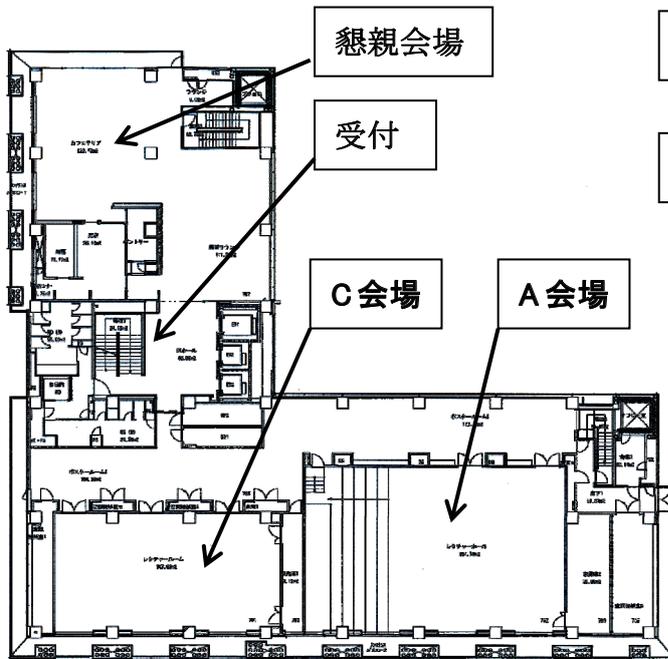
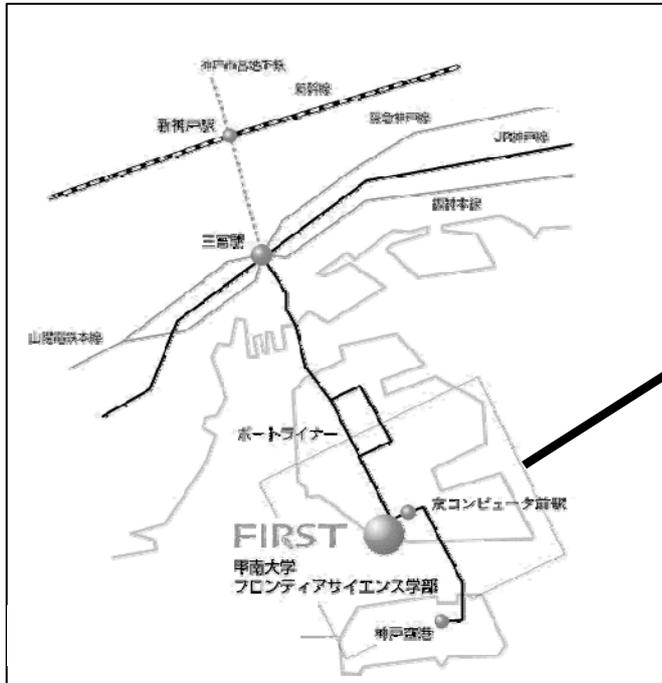


3. 優秀ポスター発表

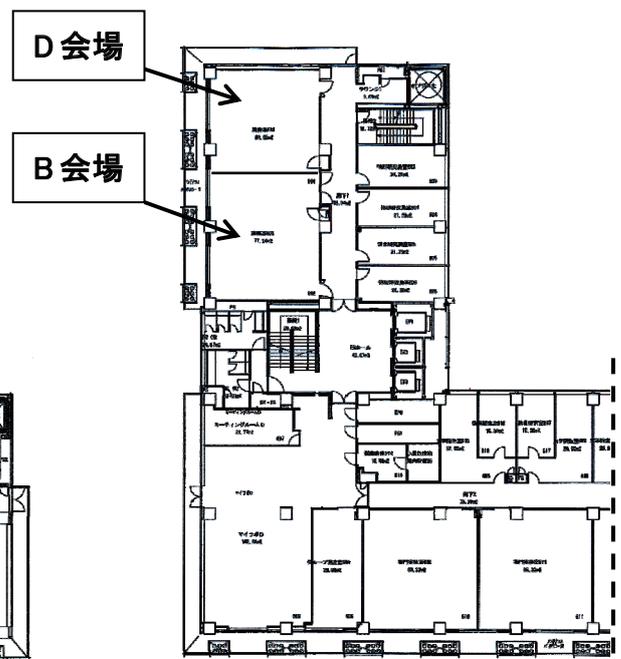
優秀ポスター発表の選出は日本真空学会講演・研究会企画委員会の定めた審査委員の審査により行います。審査対象のポスターは講演番号の末尾にVと表示されています。優秀ポスター発表の審査に応募した場合でも当日筆頭発表者が発表を行わなかった場合は審査の対象とはなりません。審査結果は15日（木）審査終了後速やかに受付付近に掲示予定です。また優秀ポスター発表の筆頭著者を懇親会に招待し、懇親会場において表彰式を行います。皆様のご協力をお願いいたします。

会場案内図

JR 神戸線、阪急、阪神三ノ宮駅からポートライナーで京コンピュータ前駅下車（乗車時間 19 分）徒歩 4 分。会場周辺には利用できる駐車場がありませんので、自動車でのご来場は固くお断りいたします。



7階



6階

真空に関する連合講演会 併設展示会

第 53 回真空に関する連合講演会 併設展示会を、下記時間に開催いたします。

日 時： 平成 24 年 11 月 14 日（水） 11：00～16：00
11 月 15 日（木） 9：00～16：00

場 所： 甲南大学ポートアイランドキャンパス C会場（7階レクチャールーム）
ポスターセッションと同じ場所です。

参加費： 無料（連合講演会参加費はお支払いの上ご覧下さい。）

出展企業：

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| ① 株式会社 大阪真空機器製作所 | ② 株式会社 岡野製作所 |
| ③ 入江工研 株式会社 | ④ 東京電子 株式会社 |
| ⑤ ケニックス 株式会社 | ⑥ 株式会社 トヤマ |
| ⑦ 有限会社 真空実験室 | ⑧ オミクロンナノテクノロジージャパン株式会社 |
| ⑨ 三愛プラント 株式会社 | ⑩ 新明和工業 株式会社 |
| ⑪ 株式会社 KRI 材料解析研究センター | ⑫ エドワーズ 株式会社 |
| ⑬ キヤノンアネルバ 株式会社 | ⑭ 株式会社 グローブ・テック |
| ⑮ テルモセラ・ジャパン 株式会社 | ⑯ 佐藤真空 株式会社 |
| ⑰ 日本カンタムデザイン 株式会社 | ⑱ グローバルネット 株式会社 |

- 併設展示会の期間中会場でコーヒーなどの飲み物のサービスをいたします。
- 出展企業との打ち合わせ、研究内容に関する討論の場としては、7階展望ラウンジ（C会場とエレベーターホールを介して反対側）をご利用下さい。

企業プレゼンテーション

昼休みの時間を利用して、出展企業からの技術プレゼンテーションを行います。

参加者*には、お弁当(毎日 50 食限定)を無料で支給いたします。

*真空に関する連合講演会に参加登録された方に限ります。

場 所： 甲南大学ポートアイランドキャンパス B会場（6階 602 講義室）

日 時： 平成 24 年 11 月 14 日（水） 12：45～13：45
11 月 15 日（木） 12：45～13：45

11 月 14 日（水） 12:50～13:00 日本カンタムデザイン 株式会社

13:00～13:10 東京電子 株式会社

13:10～13:20 有限会社 真空実験室

13:20～13:30 三愛プラント 工業株式会社

11 月 15 日（木） 12:50～13:00 株式会社 KRI 材料解析研究センター

13:00～13:10 エドワーズ 株式会社

13:10～13:20 グローバルネット 株式会社

13:20～13:30 オミクロンナノテクノロジージャパン 株式会社

企業展示会場・ポスターセッションルーム

企業展示名

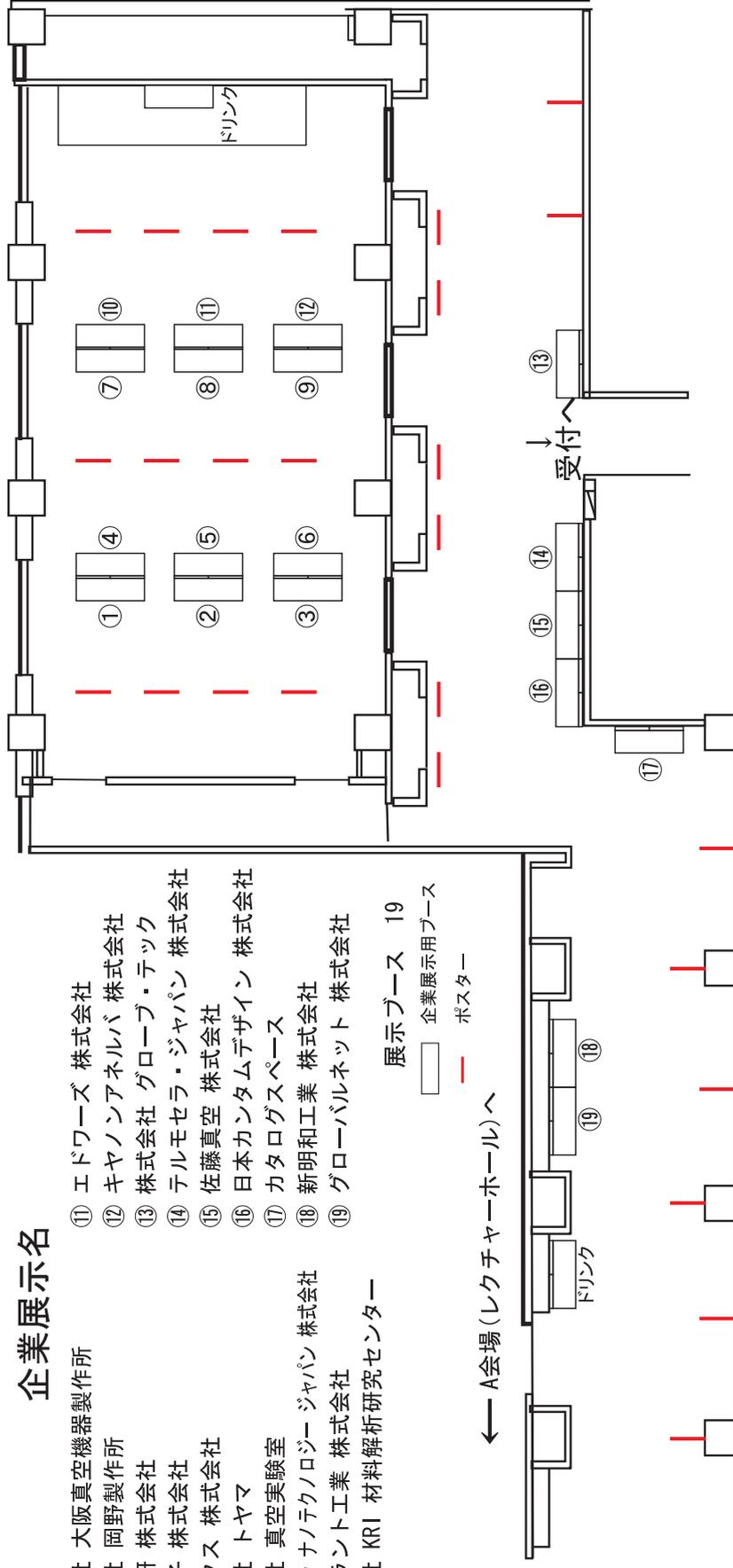
- | | |
|---------------------------|-------------------|
| ① 株式会社 大阪真空機器製作所 | ⑪ エドワーズ 株式会社 |
| ② 株式会社 岡野製作所 | ⑫ キヤノンアナルバ 株式会社 |
| ③ 入江工研 株式会社 | ⑬ 株式会社 グローブ・テック |
| ④ 東京電子 株式会社 | ⑭ テルモセラ・ジャパン 株式会社 |
| ⑤ ケニックス 株式会社 | ⑮ 佐藤真空 株式会社 |
| ⑥ 株式会社 トヤマ | ⑯ 日本カンタムデザイン 株式会社 |
| ⑦ 有限会社 真空実験室 | ⑰ カタログスペース |
| ⑧ オミクロン ナノテクノロジージャパン 株式会社 | ⑱ 新明和工業 株式会社 |
| ⑨ 三菱プラント工業 株式会社 | ⑲ グローバルネット 株式会社 |
| ⑩ 株式会社 KRI 材料解析研究センター | |

展示ブース 19

□ 企業展示用ブース

— ポスター

C会場(レクチャールーム)



← A会場(レクチャールーム)へ